

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第5部門第1区分

【発行日】平成19年7月26日(2007.7.26)

【公表番号】特表2003-500599(P2003-500599A)

【公表日】平成15年1月7日(2003.1.7)

【出願番号】特願2000-620249(P2000-620249)

【国際特許分類】

F 0 3 G 7/00 (2006.01)

【F I】

F 0 3 G 7/00 H

【手続補正書】

【提出日】平成19年5月24日(2007.5.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第一のカシミール力生成境界と第二のカシミール力生成境界の間のカシミール力に影響を与える物理因子を、第一の値から第二の値に変更するステップと、

前記第一のカシミール力生成境界と前記第二のカシミール力生成境界の間の間隔を、第一の距離から第二の距離に変えるステップと、

前記物理因子を前記第二の値から第三の値に変更するステップと、

前記間隔を前記第二の距離から第三の距離に変えるステップと、を含む方法。

【請求項2】

前記第三の値が前記第一の値に等しい請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記第三の距離が前記第一の距離に等しい請求項1に記載の方法。

【請求項4】

前記変更するステップが、前記第一のカシミール力生成境界及び前記第二のカシミール力生成境界の少なくとも一方の自由荷電担体の濃度を変更することを含む請求項1に記載の方法。

【請求項5】

第一の値から第二の値へ変更する前記ステップが、前記少なくとも一方のカシミール力生成境界に光を照射することを含み、

前記第二の値から第三の値へ変更する前記ステップが、前記照射を減少させることを含む、

請求項4に記載の方法。

【請求項6】

間隔を変え前記ステップが、前記第一のカシミール力生成境界と前記第二のカシミール力生成境界の間距離を減少させることを含む、

前記間隔を変え前記ステップが、前記第一のカシミール力生成境界と前記第二のカシミール力生成境界の間距離を増加させることを含む、

請求項5に記載の方法。

【請求項7】

前記変更するステップが、前記第一のカシミール力生成境界と前記第二のカシミール力

生成境界の少なくとも一方の温度を変更することを含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 8】

前記第一のカシミール力生成境界と前記第二のカシミール力生成境界を介して取得したエネルギーを貯蔵するステップを更に含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 9】

前記第一のカシミール力生成境界と前記第二のカシミール力生成境界の少なくとも一方が可動であり、前記変えるステップが、前記少なくとも一方のカシミール力生成境界に有効に結合されているマイクロメカニカル機器の要素を動かすことを更に含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 10】

前記第一のカシミール力生成境界と前記第二のカシミール力生成境界を介して取得したエネルギーを、電気機器に配送するステップを更に含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 11】

可変である距離によって互いに隔てられている第一のカシミール力生成境界及び第二のカシミール力生成境界と、

前記第一のカシミール力生成境界及び前記第二のカシミール力生成境界の少なくとも一方に作用するエネルギー転換システムと、
を含む装置であって、前記エネルギー転換システムは、

前記第一のカシミール力生成境界及び前記第二のカシミール力生成境界の少なくとも一方の物理因子を変更するように作用する第一の機器と、

前記第一の機器が前記物理因子を変更する間、前記距離を変えるもしくは前記距離を変えることを妨げるように作用する第二の機器と、
を含む装置。

【請求項 12】

前記第一の機器が、前記第一のカシミール力生成境界と前記第二のカシミール力生成境界の少なくとも一方に光を照射するように作用する照射源を含む請求項 11 に記載の装置。

【請求項 13】

前記第一の機器が、前記第一のカシミール力生成境界と前記第二のカシミール力生成境界の少なくとも一方を加熱するように作用する熱輻射源を含む請求項 11 に記載の装置。

【請求項 14】

前記第一の機器が電磁輻射源である請求項 11 に記載の装置。

【請求項 15】

前記第一のカシミール力生成境界の第二の側面が導電性であり、

前記第二のカシミール力生成境界の第二の側面が導電性であり、

前記第二の機器が、前記第一のカシミール力生成境界の前記第二の側面及び前記第二のカシミール力生成境界の前記第二の側面に電氣的に結合された電源である、請求項 11 に記載の装置。

【請求項 16】

前記第一のカシミール力生成境界の前記第二の側面と間隔をおいてかつ近接して配置された第一の導電性板と、

前記第二のカシミール力生成境界の前記第二の側面と間隔をおいてかつ近接して配置された第二の導電性板と、

を更に含む請求項 15 に記載の装置。

【請求項 17】

前記電源が前記第一の導電性板及び前記第二の導電性板に電氣的に結合されている請求項 16 に記載の装置。

【請求項 18】

前記第一のカシミール力生成境界の前記第二の側面及び前記第二のカシミール力生成境界の前記第二の側面が両方共第一の電位にあり、

前記第一の導電性板と前記第二の導電性板が両方共第二の電位にある、
請求項 1 7 に記載の装置。

【請求項 1 9】

前記第一のカシミール力生成境界と前記第二のカシミール力生成境界の少なくとも 一方 が、半導体及び化合物半導体から成る群から選ばれる物質を含む請求項 1 1 に記載の装置。

【請求項 2 0】

前記物質が、不純物を、該不純物が無い前記物質と較べて、輻射線に晒されたときに自由荷電担体の濃度が増加するようにドーピングされている請求項 1 9 に記載の装置。

【請求項 2 1】

前記第一のカシミール力生成境界と前記第二のカシミール力生成境界の少なくとも 一方 がマイクロメカニカル機器に有効に結合されている請求項 1 1 に記載の装置。

【請求項 2 2】

電気を消費する機器に電氣的に結合されている請求項 1 1 に記載の装置。